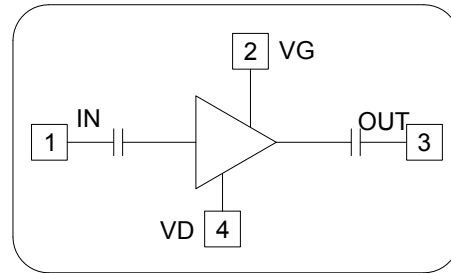


特点:

- 频率: 0.2~6GHz
- 增益: 17dB
- 输出 P-1dB 压缩点: 17dBm
- 工作电压电流: +5V@46mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 2.4×1.3×0.1mm

功能框图



性能参数: (TA=+25℃, VD=+5V, VG=-0.3V, ID=46mA)

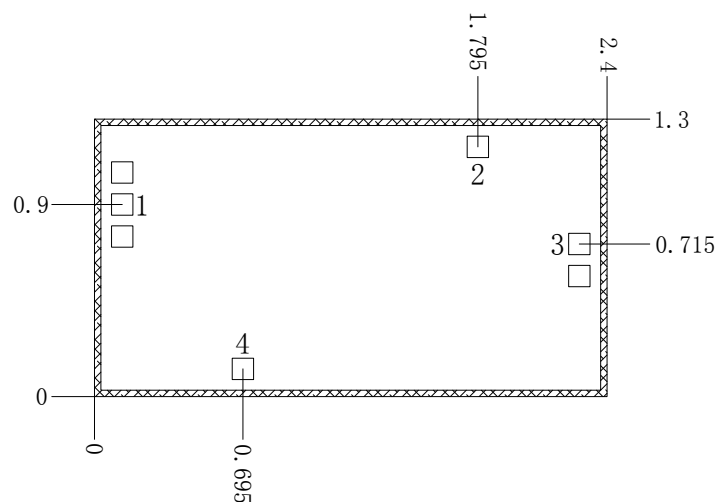
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+5.0V VG=-0.3V Zin=Zout=50Ω	0.2		6	GHz	
增益	G			17		dB	
输入驻波	VSWRi			1.5			
输出驻波	VSWRo			1.5			
噪声系数	NF			1.2	3	dB	
输出 P-1	P-1		14	17		dBm	
电压	VD	VD=+5.0V, VG=-0.3V	4.75	5	5.25	V	
电流	ID			46	70	mA	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+5.5	V	最大输入功率	+10	dBm
贮存温度	-55~+150	℃			

芯片尺寸图:

单位: mm

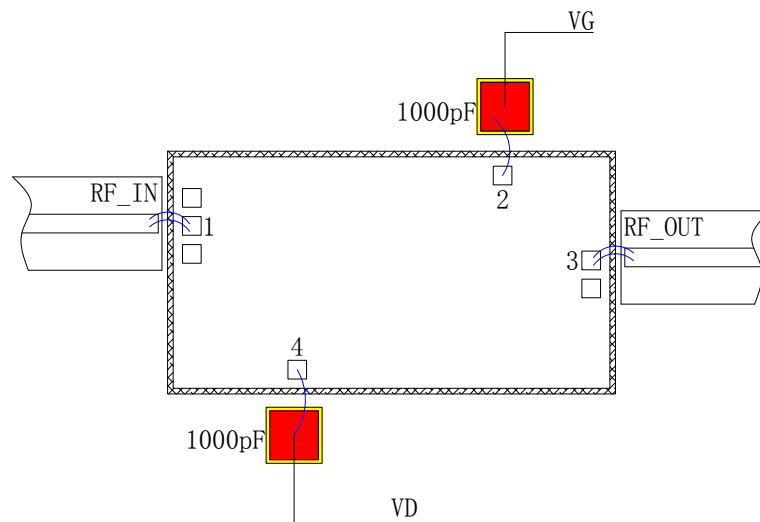


注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

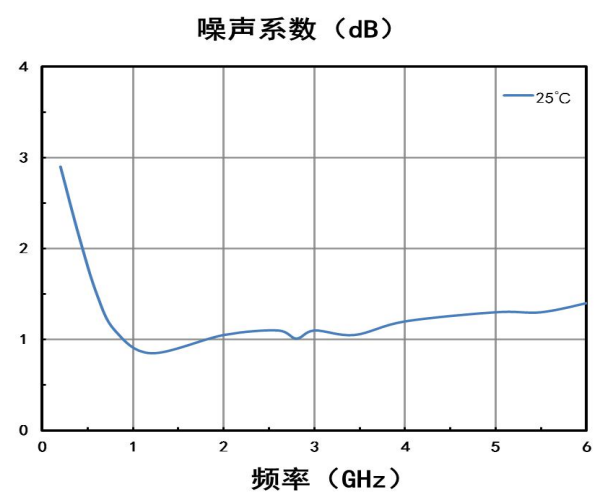
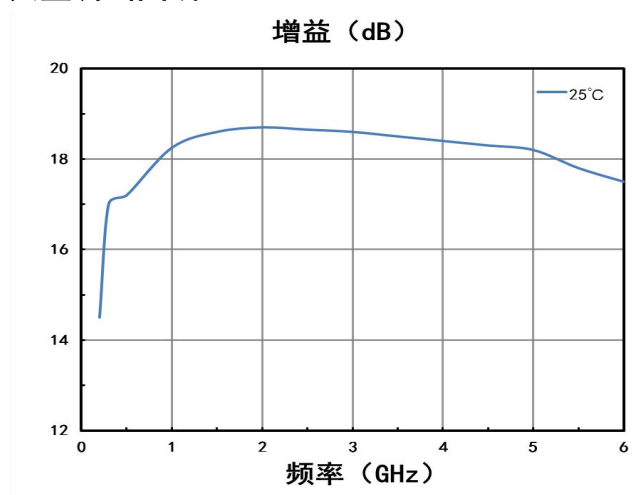
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
2	VG	放大器栅极电压，需外接 1000pF 旁路电容
3	OUT	射频输出，AC 耦合
4	VD	放大器电源电压，需外接 1000pF 旁路电容
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

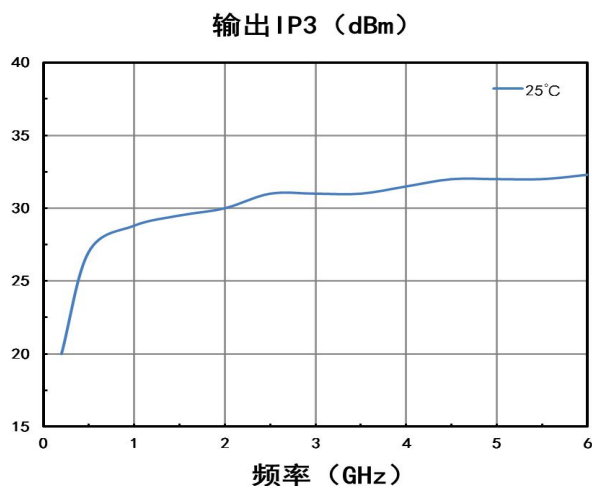
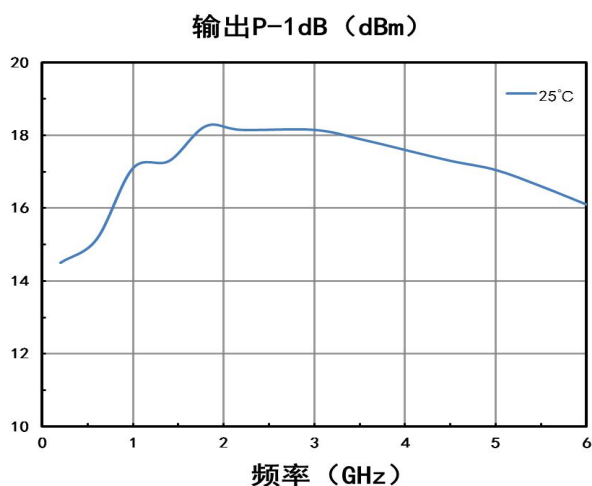
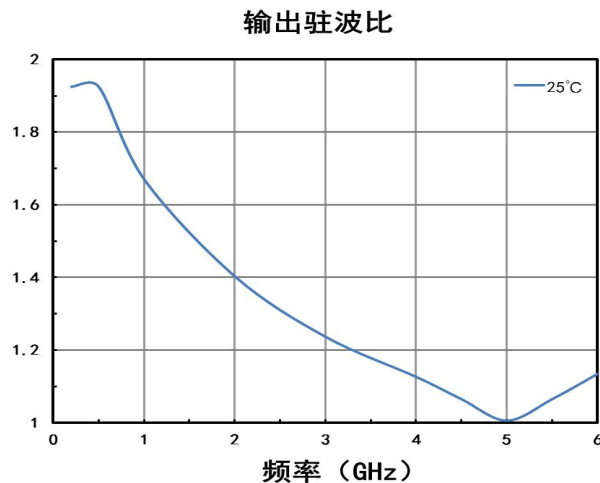
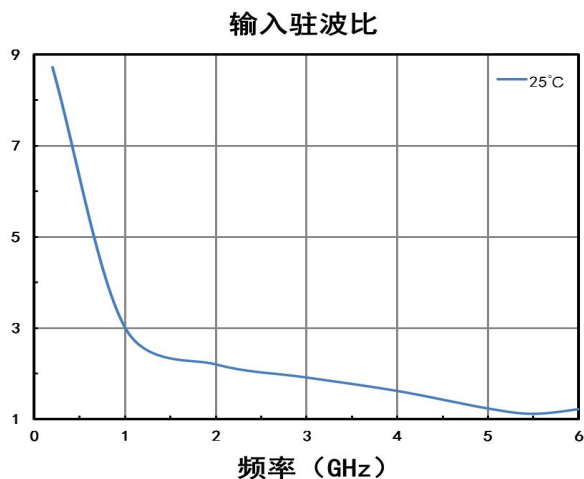
推荐装配图：



注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：





产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间断不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。